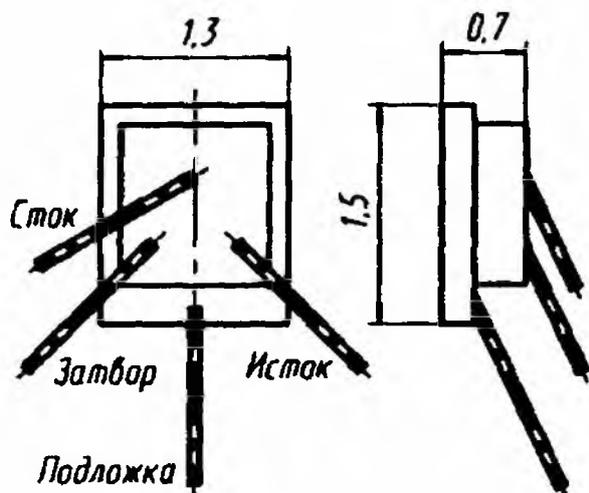


2П305А-2, 2П305Б-2, 2П305В-2, 2П305Г-2

2П305(А-2 - Г-2)



Транзисторы кремниевые диффузионно-планарные полевые с изолированным затвором и каналом *n*-типа. Предназначены для применения в герметизированной аппаратуре в усилителях высокой и низкой частот с высоким входным сопротивлением. Бескорпусные с гибкими выводами на кристаллодержателе и защитным покрытием. Каждый транзистор упаковывается в

сопроводительную тару, позволяющую без извлечения из нее производить измерение электрических параметров. Тип прибора указывается на сопроводительной таре.

Масса транзистора не более 0,005 г.

Изготовитель — Саратовский завод приемно-усилительных ламп, г. Саратов.

Электрические параметры

Максимальная рабочая частота	250* МГц
Коэффициент усиления по мощности при $U_{си} = 15$ В, $I_c = 5$ мА, $f = 250$ МГц	12*...17* дБ
типичное значение	15* дБ
Коэффициент шума при $U_{си} = 10$ В, $I_c = 5$ мА, $f = 250$ МГц	3*...6 дБ
типичное значение	4,8* дБ
Крутизна характеристики при $U_{си} = 10$ В, $I_c = 5$ мА:	
$T = +25$ °С	6...10 мА/В
$T = +85$ °С	От 1 до 0,65 значения при $T = +25$ °С
$T = -60$ °С, не более	1,5 значения при $T = +25$ °С
Напряжение затвор—исток при $U_{си} = 10$ В, $I_c = 5$ мА:	
2П305А-2	0,2...1,5 В
2П305Б-2	1...3 В
2П305В-2	-0,5...+0,5 В
2П305Г-2	-1,5...-0,2 В

Напряжение отсечки при $U_{си} = 10$ В, $I_c = 0,01$ мА, не менее:	
2П305А-2, 2П305Б-2, 2П305Г-2	6 В
2П305Б-2	2 В
Ток утечки затвора при $U_{си} = 0$, $U_{зи} = 30$ В, не более	1 нА
Входная емкость при $U_{си} = 10$ В, $I_c = 5$ мА, не более	6,8 пФ
Проходная емкость при $U_{си} = 10$ В, $I_c = 5$ мА, не более	0,8 пФ
Полная входная проводимость при $U_{си} = 15$ В, $I_c = 5$ мА, $f = 250$ МГц, не более	1* мкСм
Полная выходная проводимость при $U_{си} = 15$ В, $I_c = 5$ мА, $f = 250$ МГц, не более ..	1* мкСм

Предельные эксплуатационные данные

Напряжение сток—исток	15 В
Напряжение затвор—сток:	
при $T = -60...+25$ °С	±30 В
при $T = +85$ °С	±15 В
Напряжение затвор—исток:	
при $T = -60...+25$ °С	±30 В
при $T = +85$ °С	±15 В
Напряжение сток—подложка	15 В
Ток стока	15 мА
Постоянная рассеиваемая мощность с тепло- отводом:	
при $T = -60.. +50$ °С	80 Вт
при $T = +85$ °С	50 мВт
Температура окружающей среды	-60...+85 °С

При монтаже транзисторов в гибридной микросхеме не допускается использование материалов, вступающих в химическое и электрохимическое взаимодействие с защитным покрытием, изготовленного из диализофтальатного лака, должны быть приняты меры, исключающие соприкосновение выводов с кристаллом (минимальное расстояние от места изгиба выводов до кристалла 1 мм, радиус закругления не менее 0,5 мм).

При извлечении транзисторов из сопроводительной тары (после отсоединения выводов от тары) и монтаже транзисторов в микросхему должны применяться приспособления, не вызывающие повреждения кристалла и его защитного покрытия.

При пайке (сварке) выводов не ближе 1,5 мм и при заливке транзисторов компаундами температура кристалла не должна превышать +100 °С.